

سپاس خدایی را که سخنورا نا در ستود نا و بمانند و شمار گرا نا شمرد نا نعمتهای او ندانند، و کوشندگان، حقِّاو را گزارد ن نتوانند. خدایی که پای اندیشه تیز گام در راھ شناسایی او لنگ است، و سَر فکرتِ ژر ف رو به دریای معرفتش بر سنگ. صفتهای او تعریف ناشدنی است و به وصف در نیامدنی، و در وقت ناگنجیدنی، و به زمانی مخصوص نابودنی. به قدرتش خلایق را بیافرید، و به رحمتش بادها را بپراکنید، و با خرسنگها لرزه زمین را در مهار کشید. گواهی میدهم که خدا یکتاست، انباز یا ندارد و بیهمتاست. گواهیی از رو یا اعتقاد و ایمان، و گواهی میدهم که محمّد(ص) بنده او و پیامبر اوست. او را بفرستاد با دینی آشکار، و با نشانههایی پدیدار، و قرآنی نبشته در علم پروردگار. که نور یاست رخشان، و چراغی است فروزا ن، و دستورهایش روشن و عيان. تا گَردِ دودلی از دلها بزدايد، و با حجّت و دليل مُلزم فرمايد. ياک خدايا! چه بزر گ است آنچه می بینم از خلقت تو؛ و چه خُرد است، بزرگی آ ن در کنار قدر ت تو؛ و چه با عظمت است آنچه می بینم از ملکوت تو، و چه ناچیز است برابر آنچه بر ما نهان است از سلطنت تو، و چه فراگیر است نعمت تو در این جهان؛ و چه اندک است در کنار نعمتهای آ ناجهان. خدایا! اگر در پرسش خود درمانم یا راهِ پرسیدن را ندانم، صلاحٍ کارم را به من نما و دلم را بدانچه رستگار ي من در آ ن است متوجه فرما! از فرمایشات حضرت علی (ع)

تقدیم به:

پدر و مادر عزیزم

ابتدا وظیفه شاگرد ی خود میدانم از زحمات بی دریغ استاد راهنمای بزرگوارم، جناب آقای دکتر صالح اشرفی صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم که قطعاً بدو ن راهنمایی۔ های ارزنده ایشان این مجموعه به انجام نمیرسید. از جناب آقای دکتر حسین متولی که زحمت مشاوره و مطالعه این پایان نامه را تقبل فرمودند و اینجانب را مورد راهنمایی قرار دادند، کمال امتنان را دارم. همینطور از جناب آقای دکتر صمد سبحانیان که داور ی این پایاننامه را با نهایت دقت و صرف وقت زیاد انجام دادند، تشکر مینمایم.

در پایان از کلیه اعضای خانوادهام که همواره یار و مشوق من بودهاند، و از دوستان خوبم سرکار خانم نگار خیاط عالی و جناب آقای اختای جهان بخش سپاسگزار ی میکنم.

نام خانوادگی: بداقی حسین آبادی

نام: رقيه

اساتید راهنما: دکتر صالح اشرفی

استاد مشاور: دکتر حسین متولی

عنوان پایان نامه: مطالعه اثر دانسیته الکترونی مواد روی شدت و توزیع زاویه ای فوتونهای پراکندگیکامپتون

مقطع: کارشناسی ارشد رشته: فیزیک گرایش: هستهای دانشگاه: تبریز دانشکده: فیزیک تعداد صفحه: ۹۲ تاریخ فارغ التحصیلی: بهمن ۱۳۹۰

کلید واژہ: پراکندگی کامپتون، پس پراکندگی پرتوہای گاما، توموگرافی کامپیوتری، چشمه گاما، شبیه سازی مونت کارلو،تست غیر مخرب

چکیدہ

اگر باریکه موازی شده فوتونهای گامای 662 keV گسیل شده از چشمه ¹³⁷ Cs به یک ورقه تابانده شود، می توان با اندازه گیری شدت و توزیع زاویهای فوتونهای پراکندگی کامپتون به ساختار تشکیل دهنده قطعه پی برد. یکی از روش های مهم در انجام تستهای غیر مخرب (NDT)، استفاده از توموگرافی کامپیوتری است. اطلاعات بدست آمده در خصوص اثر دانسیته الکترونی مواد روی پراکندگی کامپتون گاما، توموگرافی کامپیوتری (CT) قطعات صنعتی را امکانپذیر می سازد. قدرت چشمه، ضخامت حفاظ سربی، فاصله چشمه و آشکارساز از نمونه و زاویه نسبی بین شکارساز و موازی ساز چشمه از عوامل موثر بر طیف بدست آمده می باشند. در این پایان نامه، حالت بهینه این شرایط را با استفاده از کد شبیه سازی موثر بر طیف بدست آمده می باشند. در این پایان نامه، حالت بهینه این شرایط را با استفاده از کد شبیه سازی MCNP4C بدست آورده ایم. اثرات وجود هر گونه غیر یکنواختی یک قطعه سرایط را با استفاده از کد شبیه سازی MCNP4C بدست آورده ایم. اثرات وجود هر گونه غیر یکنواختی یک قطعه مس، آمن، تیانیوم، آلومینیوم، شیشه، گرافیت و پلیاتیلن با ترکیب و ابعاد معلوم را تحت زاویه پراکندگی ۹۰ درجه شبیه سازی کرده و طیف تجربی هریک از قطعات را توسط آشکارساز سوسوزن (*ITT) ش*یه کردیم، برای نمونه -یوانت و به ازای ³ 7.86 gr/cm³ به علت افزایش عدد اتمی میزان تضعیف فوتونهای پراکندگی ۹۰ درجه یافت و به ازای ⁵ 7.86 gr/cm³ به علت افزایش عدد انمی میزان تضعیف فوتونهای پراکنده شده افزایش یافته و در نتیجه شدت فوتونهای ثبت شده در آشکار ساز کاهش می یابد. در آزمایش دیگر به منظور نشان دادن قدرت یافت و به ازای ⁸ میازیمای مختلف، از یک هدف چهار لایه شامل قطعات آلومنیمی و پلی اتیلنی به صورت در نتیجه شدت فوتونهای مند تعونی به آمکار ساز کاهش می یابد. در آزمایش دیگر به منظور نشان دادن قدرت مناول استفاده نمودیم . طیف تجربی بدست آمده مبنی بر قابل تمییز بودن این دو وره از همدیگر می باشد.

فهرست مطالب

| i | مقدمه |
|------|--------------------------------------------|
| ۲ | ۱–۱ بر همکنشهای پرتوهای γ و X |
| ۳ | ۲-۱ اثر فوتوالکتریک۲ |
| ٤ | ۳–۱ اثر تولید زوج |
| ٥ | ٤–١ اثر كامپتون |
| ١٤ | ۱–٤–۱ پس پراکندگی کامپتون |
| ۱٦ | ۵-۱ آشکارسازهای سوسوزن |
| ١٧ | ۱–۵–۱ سوسوزنهای گازی |
| ۱۸ | ۲–۵– ۱ سوسوزنهای آلی۲ |
| ۱۸ | ۳-۵- ۱سوسوزنهای غیر آلی(سوسوزنهای بلوری) |
| ۲۱ | ۱-۱ روشهای تصویر برداری هسته ای |
| ۲۶ | ۷–۱ بررسی منابع |
| ۳۰ | اثر پس پراکندگی کامپتون پرتوهای گاما |
| ۳۲ | ۱–۲ مقدمهای بر روش مونت کارلو |
| ۳۲ | ۱–۱–۲ تاريخچه |
| ۳۳ | ۲–۱–۲روش مونت کارلو |
| ٣٤ | ۲-۲ کد MCNP کا |
| ۳٦ N | ۱–۲–۲ تخمین خطای روش مونت کارلو کد ACNP |
| ۳۷ | ۲-۲-۲ چگونگی بکارگیری کد MCNP |
| ۳۹ | ۲-۲-۳ سطح مقطعها و دادههای هستهای در VICNP |
| ٣٩ | ٤-۲-۲ چگونگی تعریف هندسه در MCNP |
| ٤٠ | ۱–٤–۲–۲ تعریف سلول |
| ٤١ | ۲-۵-۲ تعریف سطوح |
| | |

| ٥-٢-٢ كارتهاى اطلاعات |
|---------------------------------------------------------------------|
| ۲-۲-۲ معرفی خروجی |
| ۷-۲-۲ چگونگی تعریف چشمه در MCNP |
| ۹-۲-۲ دستور خاتمه دهنده مسئله |
| ۳-۲ سیستم آشکارسازی |
| –۲–۲ ساختمان اسپکترومتر گاما– بتا (AT1315) |
| ۲–۳–۲ بکارگیری عملی اسپکترومتر |
| ۳-۳-۲ توصيف اجزاي اسپکترومتر |
| ۱–٤–۲ روشن کردن اسپکترومتر |
| ۲–٤–۲ کنترل اولیه پارامترهای دستگاه |
| ۳–٤–۲ تنظیم اسپکترومتر |
| ۱–۳ شبیه سازی سازی |
| ۱–۱–۳ طراحی هندسه آشکارساز |
| ۲–۱–۳ شبیه سازی ذرات و فرآیندها |
| ۱–۲–۱–۳ مواد بکار رفته در شبیه سازی |
| ۲–۲–۱–۳ معرفی چشمه |
| ۳–۲–۱–۳ معرفی نوع مسئله |
| ٤-۲-۱-۳ تعیین نوع خروجی خواسته شده |
| ۲–۳ توموگرافی کامپیوتری به روش پراکندگی کامپتون |
| ۱-۲-۳ مطالعه اثر چگالی مواد روی شدت فوتونهای گامای پس پراکنده شده . |
| ۲–۲–۳ بررسی پراکندگی کامپتون فوتونها در زاویه ۹۰ |
| ۱-۲-۲-۳ نتایج تجربی و شبیه سازی آزمایش در زاویه پراکندگی ۹۰ درجه |
| پیشنهادات |
| منابع |
| |

فهرست شكلها

| -۱: پديده فوتو الکتريک | شکل ۱ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| –۱: اثر توليد جفت٥ | شکل ۲ |
| '-۱: اثر کامپتون | شکل ۳ |
| -۱: مقطع دیفرانسیلی الکترونهای پراکنده شده طی پراکندگی کامپتون توسط معادله کلین-نشینا۱۹ | شکل ٤ |
| –۱: طیف پرتوها گامای Cs-137 که پیک پس پراکندگی و پیک اشعه X را نشان میدهد۱۵ | شکل ٥ |
| '-۱: طیف اندازه گیری شده پرتوهای گاما حاصل از Cs-137 شامل پیک پس پراکندگی و اشعه | شکل ٦ |
| رژی 8.0 keV و 58.0 keV و 59.3 keV | X در انہ |
| -۱ : یک نمونه از آشکارساز (NaI(Tl | شکل ۷ |
| ۱: شمایی از فوتون های عبوری و پراکنده شده از نمونه هدف | شکل ۸ |
| -۲: تغیر انرژی پرتو گامای پراکنده شده بر حسب زاویه۲ | شکل ۱- |
| -۲: نمایی از سوزن بوفون و دو خط موازی۳٤ | شکل ۲ |
| '-۲: اسپکترو متر گاما–بتا | شکل ۳ |
| -۲: جزئيات GDU ا-آشكارساز ۲-case ۳-فوتومولتي پلاير ٤-تقسيم كننده ولتاژ ٥- | شکل ٤ |
| بر ٦-شماره سریال ۷-پایانه زمین | آمپلىڧاي |
| -۲: بلوک دیاگرام اسپکترومتر | شکل ٥- |
| -۲: بلوک دیاگرام GDU | شكل7- |
| -۲: بلوک دیاگرام DPU | شكل٧- |
| -۲: اعمال ولتاژ | شکل۸- |
| -۲: تراشه 468133XXX | شکل۹- |
| -۳: طرح واپاشی برای ¹³⁷ <i>Cs</i> | شکل ۱ |
| -۳: نمودار حالت بهینه | شکل ۲ |
| -۳: نمودار حالت بهینه زاویه دید آشکار ساز نسبت به فوتونهای فرودی | شکل ۳ |
| -۳: چیدمان هندسی شبیه سازی شده در حالت بهینه۷ | شکل ٤ |

| شدت فوتونهای پس پراکنده شده بر حسب مکان۷۹ | شکل ٥–٣: |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| شبیهسازی شده فوتونهای پراکنده شده از نمونه پلی اتیلنی بدون حفره | شکل ۳-۳: |
| شبیهسازی شده فوتونهای پراکنده شده از نمونه پلی اتیلنی با حفره۷۷ | شکل ۷–۳: |
| : اسکن نمونه حفرهدار پلی اتیلن | شکل ۸–۳ |
| : چیدمان تجربی طیف تجربی زمینه | شکل ۹–۳ |
| ۲: تغیر شدت فوتونهای پراکنده شده در زمانهای مختلف۷۹ | شکل ۱۰- |
| ۲: طیف تجربی فوتونهای پراکنده شده از نمونه آهنی تحت زاویه ۹۰ | شکل ۱۱- |
| ۲: طیف تجربی شدت فوتون های پراکنده شده از نمونه مسی تحت زاویه ۹۰ | شکل ۱۲- |
| ۲: طیف تجربی فوتونهای پراکنده شده از نمونه تیتانیوم تحت زاویه ۹۰ | شکل ۱۳- |
| ۲: طیف تجربی فوتونهای پراکنده شده از نمونه آلومینیومی تحت زاویه ۹۰ ۹۰ | شکل ۱ ٤- ۳ |
| ۲: طیف تجربی فوتونهای پراکنده شده از نمونه گرافیتی تحت زاویه | شکل ۱ ۵ –۳ |
| ۲: طیف تجربی فوتونهای پراکنده شده از نمونه شیشهای تحت زاویه ۹۰ ۹۰ | شکل ۱ ٦ -۲ |
| ۲: طیف تجربی فوتونهای پراکنده شده از نمونه پلی اتیلنی تحت زاویه | شکل ۱۷- |
| ۲: طیف تجربی و شبیهسازی از نمونه آلومینیوم۲: طیف تجربی و شبیهسازی از نمونه آلومینیوم | شکل ۱۸- |
| ۲: تغییرات شدت فوتونهای پراکنده شده در ۹۰ درجه | شکل ۱۹- |
| ۲: اسکن طولی نمونه | شکل ۱۹- |

تابش های الکترومغناطیسی با انرژی بیش از 100 keV می توانند در ماده نفوذ کرده و در ااثر پراکندگی كاميتون اطلاعاتي در باره ساختار داخلي آن به ما بدهند. مثالهايي از اين نوع تصوير برداري عبارتند از: رادیوگرافی با استفاده از اشعه ایکس یا اشعه گاما که در آنها از امواجی با فرکانس های بالاتر از نور مرئی استفاده می شود. دلیل بکارگیری پر توهای گاما، قدرت نفوذ بالای آنها در ماده است. درانجام تستهای غیر مخرب (NDT)، معمولاً از اشعه ایکس و روش عبور ٰ اشعه از ماده استفاده می شود که در آن چشمه و آشکارساز در دو طرف ماده قرار می گیرند و میزان جذب فوتونهای چشمه در ماده اندازه گیری می شود. در این حالت شدت پرتو عبوری دارای اطلاعاتی مربوط به ترکیب نمونه میباشد. در مواردیکه دسترسی به دوطرف ماده امکان پذیر نیست این روش نمی تواند کاربرد داشته باشد. در مواقعی که جسم مورد مطالعه خیلی بزرگ باشد و تمامی فوتونها در آن جذب می شوند و عملاً هیچ فوتونی به آشکارساز در آن سوی جسم نمیرسد، در این حالت نیز این روش عملی نخواهد بود. می توان از روش پراکندگی به عنوان جایگزینی برای روش عبور استفاده نمود. در این روش آشکارساز و چشمه در یک طرف جسم قرار می گیرند، لذا آشکارساز به جای فوتونهای عبوری فوتونهای پراکنده شده را ثبت میکند. میتوان با تنظيم زاويه ديد أشكارساز و چشمه، اطلاعاتي از هر نقطه از ماده بدست أورد. توموگرافي کامپیوتری(CT) بوسیله پراکندگی کامپتون یک شیوه موفق برای شناسایی مواد میباشد زیرا اندرکنش

¹ –Transmission

i

چگالی ماده بستگی دارد و می توان هر گونه عدم یکنواختی در چگالی ماده را تعیین نمود. در سیستمهای مرسوم توموگرافی، برای محدود کردن حجم اسکن شده، در مقابل آشکارساز و چشمه موازیساز سربی قرار میدهند. بدین ترتیب حتی کوچکترین عیوب در هدف تحت بررسی قابل تشخیص است. هر چند در این حالت آهنگ شمارش(پالسهای آشکار شده) کم است برای افزایش آن می توان چشمهای با اکتیویته بالا بکار برد، ولی استفاده از این چشمهها برای کاربر خطرناک بوده و نیازمند بکارگیری حفاظهای سربی ضخیم میباشد که این مسئله سبب سنگین تر و غیر قابل حمل شدن دستگاه می شود. با بکار بردن چشمهای با اکتیویته پایین و حذف موازی ساز مقابل آشکار ساز ضمن افزایش راندمان، میتوان این مشکل را رفع نمود. ولی در این حالت آشکارساز از هر قسمت نمونه فوتون دریافت میکند که این عمل موجب میشود که کنترل روی حجم اسکن شده کاهش یافته و در نتیجه قدرت تفکیک فضایی تقلیل یابد. لذا برای افزایش بازده سیستم آشکارسازی، باید یک حالت بهینه در این چيدمان انتخاب شود. قدرت چشمه، ضخامت حفاظ سربي، فاصله چشمه و آشكارساز از نمونه و زاويه نسبی بین آشکارساز و موازیساز چشمه از عوامل موثر بر طیف بدست آمده می باشند. یکی از اهداف این پژوهش بررسی روش مبتنی بر انرژی پس پراکندگی کامپتون درتعیین عیبهای موجود در یک نمونه است. در این تحقیق با استفاده از کد شبیهسازی MCNP و مقایسه نتایج آن با نتایج تجربی شرایط بهینه بکارگیری چشمه، موازیساز و آشکارساز را بدست می آوریم. علاوه بر این یک سیستم توموگرافی به روش پراکندگی کامپتون در زاویه پراکندگی ۹۰ درجه را به عنوان یک روش تست غیر

فوتونها شديداً به چگالی ماده پراکننده بستگی دارد لذا اطلاعات بدست آمده از این روش مستقیماً به

مخرب معرفی نمودهایم. با استفاده از کد شبیهسازی MCNP4C سیستم مورد نظر را شبیهسازی کرده و به مقایسه نتایج حاصل از شبیهسازی این سیستم با دادههای تجربی پرداختهایم.

فصل او ل

پیشینه تحقیق و بررسی منابع

Ι το χ ε το και το και

پرتوهای γ یا X تابش الکترومغناطیسی هستند. اگر آنها را به صورت ذره در نظر بگیریم، وقتی با سرعت نور حرکت میکنند، جرم سکون و بار سکون آنها صفر است. نام مشترک برای پرتوهای γ و پرتوهای X، وقتی به صورت ذره در نظر گرفته شوند، فوتون است. رابطه بین انرژی، بسامد و طول موج λ عبارت است از[۱]:

$$\mathbf{E} = \mathbf{h}\mathbf{v} = \mathbf{h}\frac{\mathbf{c}}{\lambda} \tag{1.1}$$

اهمیت هر یک از این برهمکنشها به انرژی فوتون و عدد اتمی ماده مورد برخورد، بستگی دارد. ویژگی مهم برهمکنش پرتو X یا γ با ماده از طریق سه ساز و کار فوق، تولید ذره باردار پرانرژی(الکترون و پوزیترون) است که انرژی خود را در برخورد با ماده، با تولید یونسازی و برانگیختگی از دست میدهند. به همین دلیل گاهی اوقات پرتو X یا γ را پرتوهای یونساز غیر مستقیم مینامند[۱].

۲-۱ اثر فوتوالکتريک

در اثر فوتوالکتریک، یک فوتون جذب اتم می شود و یکی از الکترونهای اتمی، که در این مورد فوتو-الکترون خوانده می شوند، آزاد می گردد.

٣

شكل ١-١: پديده فوتو الكتريك

انرژی جنبشی ماکزیمم الکترون در این پدیده برابر است با:

 $T_e = \mathbf{E}_{\gamma} - \mathbf{B}_{\mathbf{e}} \tag{1.7}$

که E_γ انرژی فوتون فرودی و B_e انرژی بستگی الکترون است.

احتمال برهمکنش فوتوالکتریک در اتم، به شدت به دو عامل انرژی فوتون E_γ و عدد اتمی، اتم مورد برخورد (z) ، وابسته است. احتمال وقوع برهمکنش فوتوالکتریک یا به عبارت دیگر وابستگی سطح مقطع فوتوالکتریک به عدد اتمی ماده و انرژی فوتونهای γ به صورت زیر میباشد:

$$\sigma_{ph} \sim \mathbf{Z}^n$$
, $\sigma_{ph} \sim \frac{1}{\mathbf{E}_v^n}$, $3 \le n \le 5$ (1.7)

لذا اثر فوتوالکتریک در انرژیهای پایین فوتون قابل ملاحظه است.

۱–۳ اثر توليد زوج

در اثر تولید زوج با ناپدید شدن یک فوتون، یک زوج الکترون-پوزیترون به وجود میآید. وقوع این برهمکنش، نیازمند پرتوی γ با انرژی بیش از MeV ۱/۰۲ است. با عبور پرتوی γ با انرژی بیش از این مقدار، از میدان الکتریکی هسته، یک الکترون و یک پوزیترون تولید می شود (بخشی از انرژی پرتوی γ به ماده تبدیل می شود). انرژی مازاد پرتو گاما به صورت انرژی جنبشی بین ⁺e و ⁻e تقسیم می شود.



شکل۲-۱: اثر تولید جفت. گاما ناپدید و یک زوج الکترون-پوزیترون آفریده می شود. بر اثر نابودی پوزیترون دو فوتون 0.511 MeV تولید می شود.

$$E_{\gamma} - 1.02 = T_{-} + T_{+}$$
 (1.1)

در مورد این پدیده نیز، احتمال وقوع یا به عبارت دیگر وابستگی سطح مقطع تولید زوج به عدد اتمی ماده و انرژی فوتونهای γ به صورت زیر بیان می شود[۱]:

$$\sigma \sim z^n$$
, $\sigma \sim \frac{1}{E_y^n}$, $n = 2$ (1.0)

۱–٤ اثر کامپتون

پراکندگی کامپتون در سال ۱۹۲۲ توسط آرتور کامپتون^۱ با پراکندگی اشعه X از عناصر سبک کشف شد. وی در همان سال نتایج تئوری و تجربی خود را گزارش داد و در سال ۱۹۲۷ موفق به دریافت جایزه نوبل گردید[٤]. فرآیند پراکندگی کامپتون برهمکنشی است ما بین فوتون و یک الکترون آزاد. در این واکنش فوتون فرودی قسمتی از انرژی خود را به الکترون داده و فوتون جدیدی با انرژی کمتر و در مسیر متفاوتی ایجاد می شود [٥].

تئوری پراکندگی کامپتون به دو دلیل از مکانیک نسبیتی استفاده میکند: اولاً فوتونها بدون جرمند، ثانیاً انرژی انتقال یافته به الکترون قابل مقایسه با انرژی سکون آن است. بنابراین نتایج انرژی و اندازه حرکت فوتونها باید بر حسب مقادیر نسبیتی بیان شوند.

جسمی به جرم سکون m_{\circ} و سرعت حرکت \mathcal{V} دارای جرم نسبیتی m میباشد که با رابطه زیر بیان می-شود:

$$m = \frac{m_{\circ}}{\sqrt{1 - (\nu/c)^2}} \tag{1.7}$$

اندازه حرکت نسبیتی $ec{p}$ با $ec{\mathcal{W}}$ تعریف می شود بطوریکه از حاصل ضرب مجذور طرفین رابطه (۱.٦) در

⁴ خواهيم داشت:

$$m^2 - m^2 (\nu/c)^2 = m_0^2$$
 (1.V)

$$m^2 c^4 - m^2 v^2 c^2 = m_{\circ}^2 c^4, \tag{1.1}$$

¹ Arthur H. Compton

$$(mc^2)^2 - (pc)^2 = (m \circ c^2)^2, \tag{1.4}$$

$$E^2 - E_{\circ}^2 = (pc)^2.$$
 (1.1.)

$$pc = E, \quad E_0 = 0 \tag{1.11}$$

$$p = \frac{E}{c} = \frac{hv}{c} = \frac{h}{\lambda} \tag{1.17}$$

شکل (۳-۱) پراکندگی فوتونهای فرودی با انرژی E = hv را نشان میدهد.



شکل۳-۱: اثر کامپتون[٤]

مطابق پایستگی انرژی، انرژی پرتو گامای فرودی
$$hv$$
 و انرژی سکون الکترون $E_{\rm e}$ قبل از پراکندگی با
انرژی گامای پراکنده شده hv' و انرژی کل الکترون پراکنده شده $E_{\rm e}$ برابر است:
 $hv + E_{\rm e} = hv' + E_{e}$ (۱.۱۳)
از معادله (۱.۱۰) رابطه بین انرژی کل E_{e} و انرژی الکترون بعد از پراکندگی و اندازه حرکت نسبیتی \overline{p}_{e}
با رابطه زیر مشخص می شود:

$$E_e = \sqrt{(p_e c)^2 + E_o^2} \,. \tag{1.12}$$

با جایگذاری معادله (۱.۱٤) در معادله (۱.۱۳) داریم:

$$hv + E_{\circ} = hv' + \sqrt{(p'_e c)^2 + E_{\circ}^2}$$
 (1.10)

با استفاده از رابطه مابین انرژی فوتون و اندازه حرکت از رابطه (۱.۱۲) داریم:

$$pc + E_{\circ} = p'c + \sqrt{(p'_e c)^2 + {E_{\circ}}^2}.$$
 (1.17)

$$(p - p')c + E_{\circ} = \sqrt{(p'_{e}c)^{2} + E_{\circ}^{2}}$$
 (1.1V)

$$(p - p')^2 c^2 + E_{\circ}^2 + 2(p - p')cE_{\circ} = (p'_e c)^2 + E_{\circ}^2$$
(1.1A)

که جمله زیر از قانون بقای انرژی حاصل میگردد:

$$p^2 + p'^2 - 2pp' + \frac{2(p - p')E_{\circ}}{c} = p_e^2 . \tag{1.19}$$

این معادله مربوط به اندازه حرکت الکترون p_e میباشد که توسط پرتوهای گامای پراکنده شده با اندازه حرکت این معادله مربوط به اندازه حرکت الکترون در ابتدا ساکن فرض شده بطوری که امکان کافی بکارگیری حرکت اولیه p و نهایی p' است. الکترون در ابتدا ساکن فرض شده بطوری که امکان کافی بکارگیری